長庚大學 電子工程研究所博士班 必選修科目表 (108學年度入學學生適用)

		反厌大学 电十上柱研	<i>)</i> ц	71114				1111	文(108學年度人學學生	<u> </u>			
領域/組別	必選 修	科目名稱	<b>學</b> 分	開課 年級	上學期	下學 期	領域/組別	必選 修	科目名稱	學 分	開課 年級	上學 期	下學 期
共同	必修	學報討論(Seminar)	2	1	1	1							
共同	必修	科技英文寫作(1)(2)(English Technical Writing)	2	_	1	1							
共同	必修	學報討論(Seminar)	2	_	1	1							
共同		撰寫論文(Scientific Writing)	0		0	0							
共同		論文(Scientific)	6		U	U							
共円	<b>业</b> 修		U										
ты	766 (%)	積體電路技術可靠性工程	2			2							
共同	選修	(Reliability Engineering of	3	_		3							
		Integrated Circuit Techology)											
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\											
甲組	選修	半導體元件及物理 (Semiconductor Devices and	3	_	3		乙組	選修	超大型積體電路設計(VLSI Design)	3	_	3	
		Physics)											
甲組	撰修	基礎光學(Basic Optics)	3		3		乙組	選修	被動微波電路(Passive	3		3	
1 //	2 10	Elige option	Ŭ				),	~110	Microwave Circuit Design)	J		Ĭ	
甲組	避修	光電子學(Optoelectronics)	3		3		乙組	選修	電磁理論(Electromagnetic	3		3	
十四	迷眇	九电丁字(Optociccitomics)	J		)		□≅□	迷眇	Theories)	)		)	
									混合模式S參數網路分析				
甲組	選修	固態物理(Solid State Physics)	3		3		乙組	選修	(Mixed Mode S-parameter	3	_	3	
		,							Circuit Analysis)				
		先進記憶體元件(Advanced							VLSI電路模擬(VLSI Circuit				
甲組	選修	Menory Devices)	3	_	3		乙組	選修	Simulation)	3	_	3	
		積體電路專論(Special Topic							高頻量測(High-Frequency				
甲組	選修		3	_	3		乙組	選修		3	_	3	
		on VLSI Engineering)							Measurement)				
甲組	選修	微機電實驗(MEMS micro	1		1		乙組	選修	高速半導體元件(Hign Speed	3	_		3
		fabrication Lab.)							Semiconductor Devices)				
		生醫電子微流體系統							混合訊號積體電路設計				
甲組	選修	(Biomedical Electronic	3	_	3		乙組	選修	(Mixed-Signal IC Design)	3	_		3
		Microfluidic System)											
甲組	選修	光電工程概論(Principles of	3		3		乙組	選修	VLSI系統設計(VLSI System	3			3
中組	迷修	Electro-Optical Engineering)	3		3		乙組	迷修	Design)	3			3
ши	\PP //-	ルラスタク・1・・・	٥		0		→ 4.11	\PP	微波積體電路設計	0			0
甲組	選修	光電子學(Optoelectronics)	3	_	3		乙組	選修	(Microwave Integrated Circuit	3	_		3
		顯示器原理與應用(含色彩											
甲組	選修	學)(Principles and Application	3		3		乙組	選修	主動微波電路設計(Active	3	_		3
1 //17	حرا ک	of Displays)	)				7,811	الكما	Microwave Circuit Design)	)			
		量子力學(Quantum							高等超大型積體電路設計				
甲組	選修	重 1 万字(Quantum Mechanics)	3	_	3		乙組	選修		3	_		3
									(Advanced VLSI Design)				
甲組	選修	薄膜工程(Thin Film	3	_	3		乙組	選修	嵌入式系統(Embedded	3	_		3
		Technology)							System)				
甲組	選修	材料研究方法(Methods for	3		3		乙組	選修	VLSI測試設計((VLSI Testing	3			3
, ,,,,,,,	, .	Material Research)	-				-,	, _ i>	and Testable Design))	_			
甲組	選修	光電高分子及其應用(Opto-	3		3		乙組	選修	微波濾波器設計(Microwave	3	_		3
1.00	心形	Polymer & their Application)	)					心形	Filter Design)	ر			,
甲組	混合	奈米顯微技術	3		3		乙組	選修	高等數位訊號處理	3			3
十紀	迷修	<u> </u>	J		٥			迷修	(Advanced Digital Signal	J			)
шьп	3世 <i>l</i> -kテ	#m1H 1/ Ø	2		2		7411	知已 <i>[4]</i>	高速VLSI設計(Hign Speed	2			2
甲組	選修	物理光學	3	_	3		乙組	選修	VLSI Design)	3	_		3
		光電元件與系統之電性可											
	\HH * * *	靠度(Electrical reliability of						\HH * * *	高等類比積體電路設計				
甲組	選修	opto-electronic components	3	_	3		乙組	選修	(Advanced Analog IC Design)	3	_		3
		and systems)							( Id-miced / mimog ic Design)				
		先進積體電路技術							VLSI信號處理設計(VLSI				
甲組	混矿	(Advanced Integrated Circuit	3			3	乙組	混矿	Digital Signal Processing	3	_	3	
十組	迷修	_	3			)	一二組	迷修		)	_	)	
		Technology)				l .	1	J	Design)				

甲組	選修	光電半導體元件 (Optoelectronic Semiconductor Devices)	3	_		3	乙組	選修	類比積體電路設計(Analog Integrated Circuit Design)	3	11	3	
甲組	選修	固態電子學(Solid State Electronics)	3			3							
甲組	選修	奈米光電材料(Nano- Optoelectronic Materials)	3	-		3							
甲組	選修	場效半導體電子元件(Effect Semiconductor Devices)	3			3							
甲組	選修	高等電子材料學(Advanced Electronic Materials)	3	_		3							
甲組	選修	奈米元件物理(Naro-scale Device Physics)	3			3							
甲組	選修	半導體製程及元件模擬 (Semiconductor Device Design & Simulation)	3	_		3							
甲組	選修	先進高介面電層材料及應 用(Advanced High-K Material and Application)	3	_		3							
甲組	選修	固態感測元件(Solid-State Sensors)	3			3							
甲組	選修	顯示器原理與應用 (Principles and Application of	3	_		3							
甲組	選修	生醫光電學(Biophotonics)	3	_		3							
甲組		光電半導體元件 (Optoelectronic Semiconductor Devices)	3	_		3							
甲組	選修	半導體光學(Semiconductor Optics)	3	_		3							
甲組	選修	半導體雷射(Semiconductor Laser)	3	_		3							
甲組	選修	光電材料製程(Electro- Optical Material Processing)	3	_		3							
甲組	選修	高速半導體元件(Hign Speed Semiconductor Devices)	3	_		3							
甲組	選修	(Advanced Topics in VLSI	3	=	3								
甲組	選修	先進半導體元件(Advanced Semiconductor Device)	3	=	3								
甲組	選修	化合物半導體(Compound Semiconductor)	3	=	3								

備 一、畢業學分:30學分(含論文6學分)。

註 二、必修學分6學分(不含論文):學報討論4學分、科技英文寫作2學分

三、選修學分18學分。

四、其他:

1. 甲組為奈米元件及製程、乙組為電子電路設計。

- 2.學生畢業前必須選修基礎課程與核心課程。
  - (1)甲組基礎課程:半導體元件及物理。
  - (2)乙組基礎課程:超大型積體電路設計、被動微波電路,經指導教授同意選定一門。
  - (3)各組其他選修課程或共同選修課程經指導教授同意選定兩門為核心課程。
  - (4)就讀本系碩、博士班通過之基礎課程得辦理免修。
- 3. 選修外系課程經指導教授同意送學術委員會審查通過時,得認定為畢業學分。
- 4. 提出博士論文計畫書口試前完成英文檢定,檢定規定請參照長庚大學工學院博士班研究生英文能力檢測實施方案。
- 5. 學報討論一、二年級為必修,合計四學分。畢業前至少需修習四個學期並通過。
- 6.「論文撰寫」研二以上學生必修,「論文」6學分將於通過口試畢業時授與。

主管签名:	2019 04 10
十字命名,	71191419